

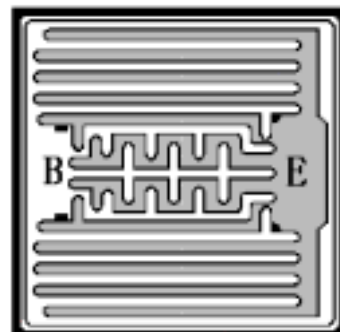


13007 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D343AG-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：3430×3430μm²
 焊位尺寸：B 极 870×475μm²；E 极 1080×480μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：KSE13007，HE13007

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T_{stg}——贮存温度..... -55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极功率耗散 (T_c=25) 80W
 V_{CB0}——集电极—基极电压..... 700V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压..... 400V
 V_{EBO}——发射极—基极电压..... 9V
 I_C——集电极电流 (DC) 8A
 I_C——集电极电流 (脉冲) 12A
 I_B——基极电流.....4A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO(sus)}	集电极—发射极维持电压	400			V	I _C =10mA, I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =9V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V, I _C =2A
		5		30		V _{CE} =5V, I _C =5A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1	V	I _C =2A, I _B =0.4A
				2	v	I _C =5A, I _B =1A
				3	V	I _C =8A, I _B =2A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =2A, I _B =0.4A
				1.6	V	I _C =5A, I _B =1A
C _{ob}	共基极输出电容		110		pF	V _{CB} =10V, f=0.1MHz
f _T	特征频率	4			MHz	V _{CE} =10V, I _C =0.5A
t _{ON}	导通时间			1.6	μs	V _{CC} =125V, I _C =5A, I _{B1} =-I _{B2} =1A
t _{STG}	载流子贮存时间			3	μs	
t _F	下降时间			0.7	μs	